

Федеральное агентство научных организаций
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук
(ИСВЧПЭ РАН)

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

подготовки аспирантов

План одобрен Ученым советом ИСВЧПЭ РАН
Протокол № 7 от 27.06.2016

11.06.01

Направление 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения: очная

Срок обучения: 4г

Виды деятельности

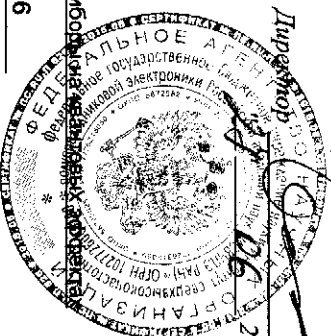
- научно-исследовательская, преподавательская

Год начала подготовки
Образовательный стандарт

2016

876

30.07.2014



Директор

Гамкрелидзе С.А.

27.06.2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научной работе

Зав. аспирантурой

Ученый секретарь

/Пономарев Д.С./

/Обухова И.Г./

/Хабидуллин Р.А./

1. Календарный учебный график

Мес	Сентябрь					Октябрь					Ноябрь					Декабрь				Январь			Февраль			Март			Апрель			Май			Июнь			Июль			Август											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Числа	1-7	8-14	15-21	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-1	2-8	9-15	16-22	23-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-31
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
I	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
II	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
III	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
IV	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
V	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

2. Сводные данные

	Курс 1				Курс 2				Курс 3				Курс 4				Итого
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Образовательная подготовка	11	7 1/3	2 2/3		11	7 1/3	2 2/3		11	7 1/3	2 2/3		11	7 1/3	2 2/3		44
П Практика		4				4				4				4			16
Н Научные исследования	30	28 2/3	37 1/3	34	30	28 2/3	37 1/3	34	30	28 2/3	37 1/3	34	30	28 2/3	37 1/3	34	120
Э Экзамены	2				2				2				2				8
Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				4				4				4				4	16
Д Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)				2				2				2				2	8
К Каникулы	9	12	12	12	9	12	12	12	9	12	12	12	9	12	12	12	36
Итого	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	208
Аспирантов	2				2				2				2				8
Сдающих канд. экз.	2				2				2				2				8
Соискателей с рук.в.																	0
Изучающих ФД																	0
Групп																	0

	ЗЕТ	Курс 4				ЗЕТ	Часы ЗЕТ в ЗЕТ нед.	Итого часов в интерактивной форме	Итого часов в электронной форме	Закрепленная кафедра
		Лек	Льб	Пр	СРС					
4	50			108		60	-			
6	20			108		60	-			
8										
9	4						-			
11							-			
12							36			
15							36			
20	4						-			
22	4						-			
23	4						36			
26							36			
29							36			
32							36			
35							36			
40							-			
42										
43							36			
46							36			
52	56					51	-			
54	ЗЕТ	Неделя		Часов		ЗЕТ	Часов в ЗЕТ нед.	ЗЕТ в нед.		
55		Итого	СР	А/А						
56							36	1,50		
57							36	1,50		
58							36	1,50		
61	ЗЕТ	Неделя		Часов		ЗЕТ	Часов в ЗЕТ нед.	ЗЕТ в нед.		
62		Итого	СР	А/А						
63	56	34		1836		51				
64	56	34		1836		51	36	1,50		
67	ЗЕТ	Неделя		Часов		ЗЕТ	Часов в ЗЕТ нед.	ЗЕТ в нед.		
68		Итого	СР	А/А						
69	6					9	-			

	Курс 4				Часов ЗЕТ в ЗЕТ нед.	Часов ЗЕТ в ЗЕТ нед.	Итого часов в интерактивной форме	Итого часов в электронной форме	Закрепленная кафедра	
	Лек	Лаб	Пр	СРС						
71	ЗЕТ	Лек	Лаб	Пр	СРС	Контроль	ЗЕТ			
72	ЗЕТ	Лек	Лаб	Пр	СРС	Контроль	ЗЕТ			
73					108		3			
74					108		3			
79										
80	ЗЕТ	Неделя			Итого	СР	Ауд	ЗЕТ	Часов ЗЕТ в ЗЕТ нед.	
81		4			216			6		
82		4			216			6	36	150

Индекс	Содержание
1	ОПК-1
Б1.В.ОД.1	Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности
Б1.В.ОД.2	Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанозлектроника, приборы на квантовых эффектах
Б1.В.ОД.3	Педагогика и психология высшей школы
Б1.В.ОД.4	Физические основы нанозлектроники
Б1.В.ОД.5	Физика поверхности полупроводников для нанозлектроники
Б1.В.ОД.5	Метаморфная технология эпитаксиального выращивания полупроводниковых наногетероструктур
Б1.В.ДВ.1.1	Технология СВЧ и КВЧ монокристаллических интегральных схем
Б1.В.ДВ.1.2	Транзисторная техника СВЧ
Б4.Г.1	Подготовка к сдаче государственного экзамена
Б2.1	Педагогическая практика
Б4.Д.1	Подготовка и написание доклада
ОПК-2	Б1.В.ОД.1 Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
Б1.В.ОД.1	Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанозлектроника, приборы на квантовых эффектах
Б1.В.ОД.2	Педагогика и психология высшей школы
Б1.В.ОД.3	Физические основы нанозлектроники
Б1.В.ОД.4	Физика поверхности полупроводников для нанозлектроники
Б1.В.ОД.5	Метаморфная технология эпитаксиального выращивания полупроводниковых наногетероструктур
Б1.В.ДВ.1.1	Технология СВЧ и КВЧ монокристаллических интегральных схем
Б1.В.ДВ.1.2	Транзисторная техника СВЧ
Б4.Г.1	Подготовка к сдаче государственного экзамена
Б2.1	Педагогическая практика
Б4.Д.1	Подготовка и написание доклада
ОПК-3	Б1.В.ОД.1 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности
Б1.В.ОД.1	Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанозлектроника, приборы на квантовых эффектах
Б1.В.ОД.2	Педагогика и психология высшей школы
Б1.В.ОД.3	Физические основы нанозлектроники
Б1.В.ОД.4	Физика поверхности полупроводников для нанозлектроники
Б1.В.ОД.5	Метаморфная технология эпитаксиального выращивания полупроводниковых наногетероструктур
Б1.В.ДВ.1.1	Технология СВЧ и КВЧ монокристаллических интегральных схем
Б1.В.ДВ.1.2	Транзисторная техника СВЧ
Б4.Г.1	Подготовка к сдаче государственного экзамена
Б4.Д.1	Подготовка и написание доклада
ОПК-4	Б1.В.ОД.1 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности
Б1.В.ОД.1	Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанозлектроника, приборы на квантовых эффектах
Б1.В.ОД.2	Педагогика и психология высшей школы
Б1.В.ОД.3	Физические основы нанозлектроники
Б1.В.ОД.4	Физика поверхности полупроводников для нанозлектроники
Б1.В.ОД.5	Метаморфная технология эпитаксиального выращивания полупроводниковых наногетероструктур

Индекс	Содержание
Б1.В.ДВ.1.1	Технология СВЧ и КВЧ монолитных интегральных схем
Б1.В.ДВ.1.2	Транзисторная техника СВЧ
Б4.Г.1	Подготовка к сдаче государственного экзамена
Б3.1	Проведение научно-исследовательской работы по направленности
Б4.Д.1	Подготовка и написание доклада
ОПК-5	готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
Б1.В.ОД.2	Педагогика и психология высшей школы
Б2.1	Педагогическая практика
ПК-1	способностью свободно владеть фундаментальными разделами физики, необходимыми для решения научно-исследовательских задач
Б1.В.ОД.1	Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах
Б1.В.ОД.3	Физические основы нанoeлектроники
Б1.В.ОД.4	Физика поверхности полупроводников для нанoeлектроники
Б1.В.ОД.5	Метаморфная технология эпитаксиального выращивания полупроводниковых наногетероструктур
Б1.В.ДВ.1.1	Технология СВЧ и КВЧ монолитных интегральных схем
Б1.В.ДВ.1.2	Транзисторная техника СВЧ
Б4.Г.1	Подготовка к сдаче государственного экзамена
Б3.1	Проведение научно-исследовательской работы по направленности
Б4.Д.1	Подготовка и написание доклада
ПК-3	Способность свободно владеть знаниями о наиболее важных и перспективных методах исследования твердого тела, определяющих развитие полупроводниковой нанoeлектроники
Б1.В.ОД.1	Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах
Б1.В.ОД.2	Педагогика и психология высшей школы
Б1.В.ОД.3	Физические основы нанoeлектроники
Б1.В.ОД.4	Физика поверхности полупроводников для нанoeлектроники
Б1.В.ОД.5	Метаморфная технология эпитаксиального выращивания полупроводниковых наногетероструктур
Б1.В.ДВ.1.1	Технология СВЧ и КВЧ монолитных интегральных схем
Б1.В.ДВ.1.2	Транзисторная техника СВЧ
Б4.Г.1	Подготовка к сдаче государственного экзамена